



## パワー半導体向け SiC エピタキシャルウェハーについて ローム株式会社と長期供給契約を締結

昭和電工株式会社（社長：森川 宏平）は、高効率 SiC パワー半導体事業をグローバルに展開しているローム株式会社（以下、ローム社）との間で、パワー半導体向け SiC エピタキシャルウェハー（以下、SiC エピウェハー）に関する、複数年にわたる長期供給契約を締結いたしました。

今般の長期供給契約の締結は、当社の優れた品質と安定供給体制をご評価いただいたものであり、先進的な開発を進めるローム社と、SiC エピウェハーの特性均一性<sup>注1</sup>、低欠陥密度<sup>注2</sup>などの向上に向けた技術的な協力関係を更に強化するものになります。

当社の SiC エピウェハーは 2009 年の上市以来、システムサーバー電源や鉄道車両、太陽光発電システム用インバーター、電気自動車の高速充電スタンド用コンバーターなど様々な用途に採用されており、大きな成長が見込まれる SiC パワーデバイス市場において、当社の SiC エピウェハー事業の拡大が期待されます。

当社グループは、世界最大（当社推定）の SiC エピウェハー外販メーカーとして、“ベスト・イン・クラス”をモットーに、急拡大する市場に高性能で高い信頼性の製品を供給し、電力損失や熱の発生が少なく、省エネルギーな SiC パワー半導体の普及に貢献してまいります。

以上

注1 特性均一性：ウェハーの特性を決める窒素のドーピング（添加）が均一にできているということ。  
SiC パワー半導体は SiC に窒素をドーピングして製造するが、高電圧用途に用いるにはドーピング量を少なくかつ薄く均一にする技術が求められる。

注2 低欠陥密度：1 cm<sup>2</sup>あたり何個の欠陥があるかで判断される。欠陥が存在するとそこから電流が流れてしまいデバイスとして使用できなくなるが、大電流化に対応して SiC チップは大型化するため、デバイスの歩留まり向上には欠陥密度を下げる必要がある。当社第2世代品（HGE-2G）は、当社従来品（HGE）に比べ 1/2 以下の表面欠陥密度を実現した。

◆ 本件に関するお問い合わせ先      CSR・コミュニケーション室      03-5470-3235